軽金属 第67巻 第7号 (2017), 284-291

1050アルミニウム熱間圧延材の回復・再結晶速度に及ぼす 固溶した不純物の影響*

吉田 英雄**・玉田 裕子**・浅野 峰生**・大久保 喜正**

Journal of The Japan Institute of Light Metals, Vol. 67, No. 7 (2017), 284–291 © 2017 The Japan Institute of Light Metals

Effect of solute impurities on the rate of recovery and recrystallization in a 1050 aluminum hot rolled sheet*

Hideo YOSHIDA**, Yuko TAMADA**, Mineo ASANO** and Yoshimasa OOKUBO**

The effect of soaking conditions of ingots on the rate of recovery and recrystallization in a 1050 hot-rolled sheet during annealing at 350°C was investigated. The rate of recovery and recrystallization in no soaking and 600°C/8 h WQ (water quenching) was slower than that of 450°C/8 h FC (furnace cooling). Many solute impurities (Fe, Si), which were contained in no soaking and 600°C/8 h WQ cause the delay of recovery and recrystallization. Particularly, in no soaking, no precipitation was observed within grains of the ingot and the hot-rolled sheet. On the other hand, in 450°C/8 h FC, the recovery and recrystallization is too fast. Fine granular precipitates with less than 0.1 μ m in diameter were observed and solute impurities were few in the ingot and the hot-rolled sheet. The pinning of sub-grain boundaries by these fine precipitates was not observed. The normalized change of Vickers hardness and electrical resistivity was divided into a recovery reaction and a recrystallization one respectively by a new developed rate equation. The role of impurities in the recovery and recrystallization was explained and made clear by the obtained values of parameters in this equation.

(Received February 3, 2017 Accepted April 6, 2017)

Keywords: soaking condition of ingot; solute impurities; rate of recovery and recrystallization; hot-rolled sheet; rate equation

1. 緒 言

工業用純アルミニウムの回復・再結晶速度は不純物である けい素や鉄の量やそれらの固溶量で変わってくることはよく 知られている^{1)~3)}。これらのけい素や鉄は鋳塊ソーキング や熱間圧延だけでなく、回復・再結晶の焼なまし過程で析出 してくることも明らかになってきた^{4)~8)}。前報では、1050 アルミニウム熱延板の回復・再結晶速度に及ぼす鋳塊ソーキ ングの影響を調べ、固溶したけい素や鉄が転位セルや亜結晶 粒界上に偏析、析出して回復・再結晶を制御していることを 速度論的な解析で明らかにした^{9),10)}。浅野らもまた1200ア ルミニウム冷間圧延板の250℃焼なまし時の亜結晶粒界を最 新の収差補正走査・透過電子顕微鏡とEDS分析を用いて観 察し、Fig.1に示すように亜結晶粒界上に不純物であるけい 素と鉄の濃度偏析が生じることを明らかにした¹¹⁾。アルミ ニウムにおける回復・再結晶段階での不純物の偏析を観察し た事例は、従来のTEMでは検出できなかったためほとんど ない。浅野らの観察結果は、回復・再結晶速度は不純物が 亜結晶粒界上に偏析することで制御されることを示唆する。 1050板材の再結晶に関する前報の論文^{9),10)}では、熱間圧延 温度を500°Cで行ったので,熱間圧延中に析出してくる粒子 も存在し,実験結果からこれらの微細粒子はその後の回復・ 再結晶速度を促進すると考えた。反対に熱間圧延中の析出を 抑制して固溶した不純物を多くした場合には回復・再結晶速 度が遅くなるかどうかを明確にするために,本研究では熱間 圧延温度をAl-Fe-Si系化合物の析出が抑制できる300°C以下 とした¹⁰。本研究の目的は、ソーキング条件で不純物の固溶 量を変え,かつ熱間圧延での不純物の析出を抑制して,熱延 板の焼なまし過程での回復・再結晶速度に及ぼす固溶した不 純物の役割を明確にすることである。

2. 実験方法

ラボの連続鋳造設備で造塊した1050鋳塊(Fe: 0.29 mass%, Si: 0.09 mass%, **Table 1**)を、不純物の固溶度と析出の影響を 調べるために鋳塊のソーキングなし(No Soaking),600°C/8h 水冷(WQ)と450°C/8h 炉冷(FC)の3条件で鋳塊熱処理 を行った。これらの鋳塊を、300°Cに再加熱し厚さ10 mm か ら5 mm まで1パスで熱間圧延を行い、約200°Cで終了した。 終了温度は接触式温度計で測定した。焼なまし処理のため に、この熱間圧延材をソルトバスにて350°Cで所定時間保持

*軽金属学会第127回秋期大会(平成26年11月)で一部発表

^{**}株式会社UACJ 技術開発研究所(〒455-8670 愛知県名古屋市港区千年3-1-12) UACJ Corporation, Research & Development Division (3-1-12 Chitose, Minato-ku, Nagoya-shi, Aichi 455-8670) E-mail: ysdslm@gmail.com

した。以上のプロセスをFig.2に示す。この焼なましを行っ た試料について、回復・再結晶過程での不純物の役割を明 らかにするために硬度変化、電気伝導度変化、ミクロ組織、 TEM 組織、SEM 組織などを調べた。硬度は板厚中心でビッ カース硬度(荷重49N)3点測定してその平均値を求めた。 ミクロ組織、TEM 組織もその板厚中央面を観察し、回復・ 再結晶過程での結晶粒の生成・成長を調べた。電気伝導度は 日本フェルスター製のSIGMATESTで測定(有効数字は4桁) した。TEM 組織観察には日本電子製 JEM-2010を、SEM 組織 観察には Carl-Zeiss 製の FE-SEM(ULTRA plus)を、EDS分 析には Bruker 製を用いた。

3. 結 果

3.1 鋳塊ソーキング後と熱間圧延後の電気伝導度

Fig. 3に鋳塊ソーキング後と熱間圧延後の電気伝導度を示 す。ソーキングによって電気伝導度が変化していることがわ かる。ソーキングを行うことで析出が生じ、ソーキングな しに比べて 600°C/8h WQ材では約 0.2%IACS、450°C/8h FC 材では約 1.7%IACS 増加した。450°C/8h FC材では電気伝導 度が大幅に増加し、析出がかなり生じていることがわかる。 300°Cでの熱間圧延では、ソーキングなしや600°C/8h WQ 材は電気伝導度の変化はわずかであるが、450°C/8h FC材で は約 0.5% IACS 程度増加する。この電気伝導度の増加量の違 いについては4.3 節で考察する。



Fig. 1 SEM and EDS mapping images of 1200 cold rolled aluminum sheet annealed at 250°C for 50 min. (a) HAADF-STEM image, (b) Bright field image, and (c), (d) EDS mapping images of Si and Fe¹¹.

3.2 350℃焼なましでの硬度変化と電気伝導度変化

(1) ソーキング条件の影響

各ソーキング材の熱間圧延板を350°Cで焼なまししたとき の硬度変化と電気伝導度変化をFig.4とFig.5に示す。なお、 焼なまし直後(0.01min)の硬度はAs Rolled材と同じとし た。Fig.4からは450°C/8h FC材が最も回復・再結晶が速く、 ソーキングなし材と600°C/8h WQ材の回復・再結晶は遅い ことがわかる。ソーキングなし材と600°C/8h WQ材の差は わずかで600°C/8h WQ材の方がソーキングなし材より若干 速い。一方、Fig.5の電気伝導度の変化からは、ソーキング なし材と600°C/8h WQ材の絶対値での変化量は大きく、固 溶した不純物原子の多くが焼なまし過程で析出してくること がわかる。450°C/8h FC材はソーキングで多くの溶質原子が 析出していたため、絶対値での全体の変化量は小さい。

(2) 規格化された硬度変化と電気伝導度変化の比較

Fig.6はFig.4の硬度変化から、反応の開始と終了の差を 1として反応開始からの硬度変化量を規格化した図である。 Fig.7も同様にFig.5の電気伝導度の変化を規格化して表示 している。Fig.7の450°C/8h FC材において長時間側で規格 化したデータが大きく変動しているのは、Fig.5で示すよう に450°C/8h FC材の絶対値の変化量が小さく、測定時のわず かな変動を拾ったためである。なお、規格化するとデータの



Fig. 2 Fabrication processes and their conditions of 1050 hot-rolled aluminum sheet from casting to annealing.



% IACS	No Soaking	600°C/8h WQ	450°C/8h FC		
Ingot	60.34	60.55	62.08		
Hot rolled sheet	60.37	60.67	62.59		

Fig. 3 Electrical conductivity of ingots and hot-rolled sheets.

Table 1 Chemical composition of 1050 ingot (mass%).

Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	В	Ni	V	Ga
0.09	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01	0.01



Fig. 4 Effect of soaking conditions on the change in the Vickers hardness in 1050 aluminum sheet annealed at 350°C.



Fig. 5 Effect of soaking conditions on the change in the electrical conductivity in 1050 aluminum sheet annealed at 350°C.



Fig. 6 Normalized change of the Vickers hardness shown in Fig. 4.

ばらつきのために1をわずかに越す場合もあるので,縦軸の 最大値を1.2とした。Fig.6とFig.7を比べると,ソーキング なし材と600°C/8h WQ材では硬度と電気伝導度の時間変化 が同じでなく,電気伝導度の変化が硬度変化より早く始まっ たことがわかる。前報の結果^{9),10)}では硬度変化も電気伝導 度の変化もほぼ同じ時間変化を示し、ミクロの再結晶挙動も 同じ変化を示したが、今回の電気伝導度の結果は前報と異な ることがわかった。これは前報と異なり圧延温度を300℃と



Fig. 7 Normalized change of the electrical conductivity shown in Fig. 5.

したことが影響していると考えられ、以下の考察の中で述べる。

4. 考 察

4.1 解析に用いた速度式とそのパラメータ

(1) 速度式の導出

回復・再結晶に及ぼすソーキング条件の影響に関して、その速度論的解析を前報と同様に山本の速度式^{12)~14)}をベースに導出した速度式で解析する。

Johnson-Mehl-Avrami(JMA)式は一般に新相の割合yで 表されることが多い^{15),16)}。

$$y = 1 - \exp\left\{-\left(\frac{t}{\tau}\right)^n\right\}$$
(1)

nは指数(時間指数)である。rは時定数(寿命)すなわち 原子が旧相にとどまる平均寿命を表す¹²⁾。この式は粒子生 成速度dN/dtが一定と仮定されて導出されているために、粒 子生成速度が一定でない場合には適用できない。これに対し 山本は析出などの相変態における核生成は統計的集団現象と して生じるものであるから、その数の増加は指数関数的に変 化し、時刻t=0での旧相粒子数を N_0 、その時定数を t_2 とする と時刻tでの新相粒子数Nは次式で表されるのが自然と考え た。旧相粒子には新相粒子が形成されるサイトである格子欠 陥が含まれる。

$$N = N_0 \left\{ 1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau_2}\right) \right\}$$
(2)

新相粒子の数の増加速度」は次式で表される。

$$I = \frac{dN}{dt} = \frac{N_0}{\tau_2} \exp\left(-\frac{t}{\tau_2}\right)$$
(3)

この旧相粒子は複数の格子欠陥や生成条件などが関与して形 成されるために,式(2)を拡張して,次式で表せるとした。

$$N = N_0 \left\{ 1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau_2}\right) \right\} \left\{ 1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau_3}\right) \right\}$$
$$\cdots \left\{ 1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau_n}\right) \right\} \cong N_0 \left\{ 1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau_2}\right) \right\}^{n_2}$$
(4)

山本は粒子数変化を示す式(4)を式(1)に組み込むことで新 しい反応速度式を提案した。次式が山本の速度式である。y は生成した新相粒子の割合を示す。

$$y = 1 - \exp\left[-\left(\frac{t}{\tau}\right)^{n_1} \cdot N\right]$$
$$= 1 - \exp\left[-\left(\frac{t}{\tau_1}\right)^{n_1} \left\{1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau_2}\right)\right\}^{n_2}\right]$$
(5)

式(5)の中に粒子数の変化を表す粒子数項が含まれること がわかる。式(5)は粒子生成速度 I=dN/dtが一定とすると、 Johnson-Mehl-Avramiの式(1)になる。 n_1, n_2 は指数で、 τ_1, τ_2 は時定数である。前報と同様に回復過程と再結晶過程の二つ の反応が生じているとして、次式を用いて解析した。

$$y = A \cdot y_1 + B \cdot y_2$$

$$= A \cdot \left\{ 1 - \exp\left[-\left(\frac{t}{\tau_1}\right)^{n_1} \left\{ 1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau_2}\right) \right\}^{n_2} \right] \right\}$$

$$+ B \cdot \left\{ 1 - \exp\left[-\left(\frac{t}{\tau_3}\right)^{n_3} \left\{ 1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau_4}\right) \right\}^{n_4} \right] \right\}$$
(6)

$$\tau_{l} = \frac{1}{D} \cdot \left\{ \frac{k}{N_{0}} \right\}^{\frac{1}{n_{l}}} \cdot \left(\frac{C_{\beta} - C_{E}}{C_{l} - C_{E}} \right)^{\frac{n_{l} - 1}{n_{l}}}$$
(7)

式(7)の導出については前報で報告している^{9),10)}。ここで kは定数, C_I は母相の溶質原子濃度, C_β は析出相である β 相 の溶質濃度, C_E は β 相と母相との界面での溶質原子濃度で ある。 τ_3 も式(7)の $n_1 \epsilon n_3$ に置き換えて同様に表記できる。 n_3, n_4 は指数で, τ_3, τ_4 は時定数である。A, Bはそれぞれの反 応の比率を表す。 $A+B\approx1$ である。前報でも述べたように長 時間の析出ではわずかではあるが凝集化などによる第三の反 応も考えられるのでA+B=1とならない場合もある。

(2) 速度式のパラメータ,指数と時定数の物理的意味

ー次元拡散が支配的な場合は指数 $n_1=0.5$ で、二次元拡散が 支配的な場合は指数 $n_1=1$ となる。三次元拡散が支配的な場 合は前報で述べたように指数 $n_1=1.5$ となる^{9),10)}。それぞれの 指数での τ_1 は式(7)から以下のようになる。

$$(-\not \not k \vec{\pi}) \quad \tau_1 = \frac{k^2}{DN_0^2} \cdot \left(\frac{C_I - C_E}{C_\beta - C_E}\right) \tag{8}$$

$$(\Box \not k \overline{\pi}) \quad \tau_1 = \frac{k}{DN_0} \tag{9}$$

$$(\equiv \not \! k \, \overline{\pi}) \quad \tau_1 = \frac{1}{D} \cdot \left\{ \frac{k}{N_0} \right\}^{\frac{2}{3}} \cdot \left(\frac{C_\beta - C_E}{C_I - C_E} \right)^{\frac{1}{3}} \tag{10}$$

旧相(格子欠陥)の時定数 τ_1 は式(8),(9).(10)を用いて、 固溶した溶質原子濃度(以下,不純物濃度と記す) C_1 や初期 の粒子数 N_0 (本研究では析出粒子の析出サイト数を意味す る)の影響を調べることができる。指数 n_1 =0.5の場合は,一 次元拡散(転位パイプ拡散)による転位上への析出を意味し、 式(8)に示すように母相の不純物濃度 C_1 に比例し、濃度が 高くなると反応の時定数 τ_1 が大きくなる。すなわち回復や 再結晶の反応が遅くなることを意味する。指数 n_1 =1 は式(9) の二次元の場合で、二次元拡散(粒界拡散)による粒界面上 への析出を意味し、不純物濃度C,に無関係となり、m=1.5は 三次元拡散(格子拡散)による粒内析出を意味し、式(10) のt₁から不純物濃度C,の1/3乗で反比例する。すなわち不純 物原子濃度が高いほど回復・再結晶の反応が速くなる。ま た、いずれの指数の場合も初期の析出サイト数N₀には指数 乗で反比例し、初期の析出サイト数が多いほうが時定数t₁は 小さくなる。すなわち反応は短時間で終了する。

4.2 速度式による解析結果

Fig. 8(a), (b), (c) は Fig. 6 に示したソーキングなし材. 600°C/8h WQ材、450°C/8h FC材の規格化された硬度変化を 式(6) で解析した結果である。測定された硬度変化のデータ は図中に Experimental Data (Exp. Data) として示した。いず れの実験データも前報と同様に $y_1 \ge y_2$ の二つの式の重ね合 わせとして表すことができた。なお、カーブフィッティング で得られた $y_1 \ge y_2$ の二つの式による曲線およびその重ね合



Fig. 8 Superimposition of the new rate equation with the values shown in Table 2 on the experimental data (normalized) of the Vickers hardness.

わせの曲線y上に元の実験データのプロットと同じ時間の計 算結果のプロットも表示している。これは各曲線が重なって 見えにくいためと実験データと計算結果の差異をわかりやす





くするためである。同様に, Fig. 9(a), (b), (c) はFig. 7に 示したソーキングなし材, 600°C/8h WQ材, 450°C/8h FC材 の規格化された電気伝導度変化を式(6) で解析した結果であ る。この変化もy1とy2の二つの式の重ね合わせとして表すこ とができた。硬度変化と電気伝導度変化の解析に用いた各パ ラメータの値をTable 2に示す。硬度変化と電気伝導度変化 のいずれのソーキング条件も式y1の反応はn1=0.5、式y2の反 応はn₃=1.0で解析できることがわかる。これは前報の結果と 同じである^{9),10)}。前報では式(6)のy₁の時定数τ₁は硬度変化 でも電気伝導度の変化でもほぼ同じ値を有していたが、今回 の結果は、硬度ではソーキングなし材がr1=10,600°C/8h WQ 材がτ」=12であるのに対し、電気伝導度ではそれぞれ、τ1=4 あるいはτ1=5と時定数が小さくなっており、これらの値は電 気伝導度変化が硬度変化よりも短時間で生じることを意味す る。これはy2の時定数t3も同様であった。以上のことは、3.2 節で述べたようにソーキングなし材と600℃/8h WQ材に関 しては硬度と電気伝導度の時間変化が同じでなく、電気伝導 度の変化が硬度変化の前に先行して早く始まったことが反応 式の時定数に反映されていることがわかる。電気伝導度変化 はマトリックスの固溶原子の変化を示し、硬度変化は格子欠 陥の安定性を示すものと考えられる。硬度変化については工 業用純アルミニウムの強化機構は主要には鉄原子と転位の反 応による加工硬化であり工業的にも利用されている。本研究 の硬度変化では不純物量が少ないため固溶体硬化などの硬化 機構の影響を考慮する必要はないと考える。回復と再結晶の 比率、AとBについては、けい素や鉄の不純物の析出と関連 していると考えられるが、詳細な検討は今後の課題である。

4.3 組織観察

(1) ソーキング後の組織

铸塊ソーキング後の析出状態を観察したのが Fig. 10 であ る。上段が光学顕微鏡によるミクロ組織で、下段が TEM 組 織である。ソーキングなし材では、鋳塊の結晶粒界あるいは デンドライトセル境界上に鋳造時に生成した晶出物が観察さ れるのみである。600°C/8h WQ材では、デンドライトセル 境界や結晶粒界にあった晶出物は熱処理により分断化、粒状 化していた。TEM 組織では粗大な棒状の晶出物以外に粒内 に数μm 程度の Al₃Feの析出物(Fig. 10 では三角形状に見え ている)が観察された。これは鋳塊のソーキング時に生成し た化合物である¹¹。450°C/8h FC材では、ミクロ組織から晶 出物はソーキングが低温なため分解せずに結晶粒界やセル境 界に残存しているのがわかる。また粒内には微細な析出物が 均一に析出しているように見えるが、TEM で観察すると直

 Table 2
 Values of parameters obtained by curve-fitting of the experimental data (normalized) of the Vickers hardness and the electrical conductivity using equation (6).

	Soaking	A	nı	τι	<i>n</i> ₂	τ2	В	n ₃	τ3	n4	τ4
Vickers hardness	No soaking	0.4	0.5	10	0.5	0.5	0.55	1	25	5	60
	600°C/8h WQ	0.44	0.5	12	0.5	0.5	0.56	1	28	3	40
	450°C/8h FC	0.66	0.5	1	0.5	0.5	0.32	1	0.2	3	40
Electrical conductivity	No soaking	0.63	0.5	4	0.5	0.5	0.34	1	5	5	5
	600°C/9h WQ	0.68	0.5	5	0.5	0.5	0.32	1	4.8	2	15
	450°C/9h FC	0.38	0.5	1	0.5	0.5	0.5	1	0.15	3	40



Fig. 10 Effect of soaking conditions on the micro- and TEM structures of ingots.

径が0.1 µm以下の粒状化合物が線状に析出していることがわ かった。このような線状に析出する理由は不明である。この 微細析出はFig. 3のソーキング後の電気伝導度の変化からも 裏づけられる。

(2) 熱間圧延後の組織

Fig. 11 は熱間圧延後のTEM組織である。a)のソーキン グなし材やb)の600°C/8h WQ材には多くの転位や転位セ ル、1~2µm径の亜結晶粒が観察されるのに対し、c)の 450°C/8h FC材では亜結晶粒と微細粒子が観察される。c) の破線で示した白枠内をさらに拡大したのがd)で、この微 細粒子は亜結晶粒界と関係なく存在し、亜結晶粒をピン止 めする様子は観察されていない。この微細粒子はFig. 12の SEM 像では約0.1 µm 幅0.2 µm 長さの楕円体粒子として観察 されたが、EDS分析から明らかなようにAl-Fe-Si系化合物で ある。この微細粒子はソーキングなし材や600°C/8h WQ材 の熱間圧延材には観察されていないので、Fig. 10に示した 450°C/8h FC材の鋳塊ソーキング時に析出した化合物が粗大 化したものである¹⁾。これはソーキング後と熱間圧延後での 微細粒子に関して、その数密度がFig. 10とFig. 11d)を比較 すると熱間圧延中に粒子数は約半減し、粒子を球状と仮定し て計算するとその全体積比は約1.3倍に増加していたことか らも裏づけられる。すなわちソーキング時に析出した粒子は オストワルド成長により小さな粒子は再固溶して析出物の数 密度は減少し、大きな粒子は成長する。さらにこの粒子上に 固溶していた不純物原子が析出したと考えられる。このこと はFig.3の熱間圧延前後の電気伝導度変化(熱間圧延後の電 気伝導度からソーキング後の鋳塊の電気伝導度を引いた値) で、450°C/8h FC材ではその変化量が約0.5%で他のソーキ ング条件よりも大きくなり、熱間圧延中に析出が促進された ことからもわかる。

(3) 焼なまし後の組織

熱間圧延板の350℃焼なましでの板厚中央面における回 復・再結晶過程の組織変化をFig. 13に示す。ソーキングな し材では45minで再結晶が始まったところで、600℃/8h WQ 材の45minでは再結晶がすでに約4割進行していた。これに 対し、450℃/8h FC材では6minで再結晶が進行していて、 45minでは完了していた。これらの傾向はFig. 4やFig. 5の硬



Fig. 11 Effect of soaking conditions on the TEM structures of as hot-rolled sheets. The area surrounded by the white dotted line in c) was enlarged in d).



Fig. 12 SEM/EDS analyses of fine compounds and matrix in the hot-rolled sheet soaked at 450°C/8h FC. Sum Peak is a kind of ghost peak and should be ignored.

度変化とほぼ対応している。

Fig. 14はソーキングなし材の350°C/300min焼なまし後の 低倍率と高倍率のTEM写真である。焼なまし過程で電気伝 導度が大きく変化したソーキングなし材や600°C/8h WQ材



Fig. 13 Effect of soaking conditions on the change of the microstructures in the center plane (L-LT plane) of 1050 aluminum sheet annealed at 350°C.



Fig. 14 Dislocation structures (low and high magnification) within the grain after annealing at 350°C/300 min in the hot-rolled sheet produced using no soaking ingot.



Fig. 15 Effect of annealing on the microstructures of the hot-rolled sheet produced using no soaking ingot. Fine Al-Fe-Si compounds precipitate during annealing at 350°C.

では再結晶後も粒内に多くの転位が残存しているのが観察された。これらの転位は熱間圧延で導入された転位が残存した ものである。またFig.15に示すように、ソーキングなし材 の焼なまし前後のミクロ組織から微細なAl-Fe-Si系化合物が 焼なまし過程で粒内に析出することがわかった。この焼なま しで析出した化合物の形成は、Fig.1にも示したように、亜 結晶粒界形成過程で不純物であるけい素や鉄が亜結晶粒界へ の偏析、析出して亜結晶粒の成長を抑制し¹¹⁾、その後凝集 化したため粒界移動が容易になり、結晶粒成長とともに結晶 粒界を外れて再結晶粒内に残存したと推定される。ソーキン グなし材や600°C/8h WQ材の焼なまし時の電気伝導度の大 幅な増加はこの微細化合物の析出によるものと考えられる。

4.4 回復・再結晶速度と速度式のパラメータ

(1) 指数n1,n3と固溶した不純物の析出機構

速度論的解析から、硬度変化も電気伝導度もy1とy2の二つ の式に分離することができた。前報^{9),10)}でも明らかにした ように、y1は指数n1が0.5で主としてけい素の転位や転位セ ル境界上への偏析、析出を意味し、転位セルから亜結晶粒が 形成される回復過程を表す。y2は指数n3が1.0でけい素と鉄、 中でも鉄の二次元拡散、すなわち界面への偏析、析出を意味 し、亜結晶粒が消滅して再結晶粒が生成する再結晶形成過程 を表す。すなわち、固溶した不純物の亜結晶粒界への偏析、 析出が進行し、その後凝集化して化合物粒子を形成する。そ の結果粒界移動が生じやすくなり、亜結晶粒が消滅して再結 晶粒が生成する過程である。さらに再結晶粒界にも同様に不 純物が偏析、析出し再結晶粒成長を抑制すると考えられる。 硬度変化の速度論的解析結果は前述したようにFig.13に示 すミクロ組織の変化に対応する。

(2) 硬度変化と電気伝導度変化の時定数71の違い

電気伝導度の変化は前報9,10)と異なり、硬度変化と一致 せず, 硬度ではソーキングなし材と600°C/8h WQ材のτ1が それぞれ10および12であるのに対し、電気伝導度ではt1が それぞれ4および5と小さくなり、電気伝導度の変化が硬 度変化より早く生じる。この理由は熱間圧延温度が前報の 500°Cに比べ300°Cと低く、Fig. 11に示すように熱間圧延時 に導入された転位が固溶した不純物原子(特に鉄)と反応し 熱間圧延後も多くの転位などの格子欠陥が残存し、不純物原 子の析出が容易になったためと推定される。これは式(8)の Noが大きくなり、時定数r1が小さくなることを意味し、こ の結果、電気伝導度の変化が早く生じた。しかしながら、不 純物原子が析出しても、Fig. 14に示すように転位、亜結晶粒 界などの格子欠陥は容易に消滅しないために、硬度の変化は 電気伝導度の変化より遅くなったと考えられる。これは欠陥 の安定化に鉄原子が大きく寄与しているためである。粒内の 転位が残存しやすいことは、Fig.4に示すように350℃で長 時間焼なましても450°C/8h FC材と同程度までは硬度が低下

J. JILM 67 (2017. 7)

しないことによっても裏づけられる。またソーキング条件の 影響では硬度変化や電気伝導度変化いずれも450°C/8h FC材 の時定数r₁が小さくなる。これは式(8)のC₁からわかるよ うに固溶度が影響して、450°C/8h FC材では固溶した不純物 濃度が小さいからである。

(3) 粒子数項のパラメータ n2, T2, n4, T4

回復過程 y_1 の粒子数項のパラメータ n_2 , τ_2 はソーキング条件に依存せず硬度変化も電気伝導度変化も $n_2=0.5$, $\tau_2=0.5$ であった。一方,再結晶過程 y_2 では粒子数項のパラメータは $n_4=2\sim5$, τ_4 は硬度ではあまり変動はないが,電気伝導度ではソーキング条件で変動した。

回復過程は析出サイトも指数関数的に変動するが,指数n2 が0.5で転位や転位セルなどの格子欠陥が特にけい素の析出 により消滅していくことに対応するものと考えられる。こ の回復過程はFig.9に示すように電気伝導度の観点からみる と、ソーキングなし材や600°C/8h WQ材では再結晶反応終 了後も長時間進行する。これはFig.14に示すように転位組 織の残存のためと考えられる。一方,再結晶過程は亜結晶粒 界や再結晶粒界への析出が考えられ、この析出サイトの生成 過程は偏析や析出物の凝集化による亜結晶粒の成長や合体, 粒界上での第二相粒子の形成などいくつかの複合反応によっ て決まってくるのでn2は大きな値を示す。

(4) ソーキングで析出した化合物の役割

Fig. 10の鋳塊やFig. 11の熱間圧延板に示すように600°C/8h WQ材においても数µmのAl₃Feの析出粒子が粒内に観察され るが、熱間圧延板のTEM組織はソーキングなし材と大差な く、また焼なましでの回復・再結晶速度はソーキングなし材 と大差ないので、これらの化合物は熱間圧延中の動的回復や 焼なまし時の回復・再結晶を速める役割はほとんど担ってい ないと考えられる。

450°C/8h FC材ではソーキング中に微細粒子が析出することで、粒内の固溶度が減少するために残存できる転位が少なくなり、また熱間圧延中に導入された転位は微細粒子近傍で動的回復が生じて消滅しやすくなる。これはFig.11のTEM 組織で転位が少ないことやFig.4に示すように450°C/8h FC 材のAs Rolledの硬度が他のソーキング条件に比べ小さくな ることからも裏づけられる。また焼なまし時も固溶した不純物が少ないために回復の反応も速く、回復過程での硬度変化 も電気伝導度変化もTable 2に示すようにτ₁はともに1となった。

5. 結 🔤

(1) 1050 アルミニウム熱間圧延材の焼なましによる回 復・再結晶過程を硬度, 電気伝導度, 組織観察より調べた結 果, ソーキングなし材と600°C/8h WQ材の回復・再結晶が 遅く, 450°C/8h FC材が非常に速いことが明らかとなった。

(2) 電気伝導度の測定結果から、ソーキングなし材と 600°C/8h WQ材の回復・再結晶が遅いのは固溶した不純物 であるけい素と鉄が多く、450°C/8h FC材の回復・再結晶が 速いのは不純物の固溶度が少ないことに対応する。固溶した 不純物であるけい素と鉄が回復・再結晶速度を制御してい る。 (3) 焼なまし時の硬度変化と電気伝導度変化を次式の速 度式で、回復速度式y₁と再結晶速度式y₂の和として表すこと ができた。



いずれのソーキング条件も回復での速度式の指数はn₁= 0.5, 再結晶での速度式ではn₃=1.0となった。これは回復段 階では転位あるいは転位セル上へ, 再結晶段階では亜結晶粒 界への固溶した不純物の偏析, 析出が関与していることを示 唆するものである。

(4) ソーキングなし材においては、熱間圧延後も粒内に は微細析出物はまったく観察されず、多くの転位を含む転位 セルや亜結晶粒で構成されていた。よってソーキングなし材 の再結晶速度が遅いのは微細析出物によるピン止め効果では ないといえる。一方、450°C/8h炉冷ではAI-Fe-Si系の0.1µm 以下の微細な粒状化合物がソーキング時に析出したが、再結 晶速度は微細析出物がない場合よりも遅くならず、むしろ速 度を速めていることが明らかとなり、微細析出物によるピン 止めは見られなかった。

(5) 不純物と回復・再結晶過程との関係は, 焼なまし時 に固溶した不純物が焼なまし時に転位セル境界あるいは亜結 晶粒界に偏析, 析出して亜結晶粒の成長を抑制し, その後析 出物が凝集化することで亜結晶粒が成長して粒界を外れる。 その結果再結晶した粒内に多くの微細化合物が観察される。 工業用純アルミニウムの回復・再結晶過程は固溶した不純物 の偏析, 析出, 凝集化が関与していて, これらの反応が回 復・再結晶速度を律速している。

謝辞

本論文執筆にあたり,有益なコメントを頂いた元京都大学 山本 悟博士に謝意を表します。

参考文献

- 1) 小菅張弓, 岡田 浩: 軽金属, 61 (2011), 274-294.
- 2) アルミニウムの組織と性質、軽金属学会、(1991)、171-191.
- 3) 吉田英雄:住友軽金属技報,54(2013),62-105.
- 4) 森山 勉, 吉田英雄, 土田 信: 軽金属, 39 (1989), 184-189.
 5) 森山 勉, 吉田英雄, 土田 信: 住友軽金属技報, 30 (1989),
- 5) 森山 勉, 吉田英雄, 土田 信:住友軽金属技報, 30 (1989), 1-7.
- 6) 吉田英雄: 軽金属, 64 (2014), 179.
- 7) 東海林了,藤倉潮三:古河電工時報,No.84 (1989),116-121.
 8) 松尾 守,村松俊樹,浅沼 彰,梶山 毅,福田政志:軽金属,
- **38** (1988), 400–406.
- 9) 吉田英雄, 大久保喜正: 軽金属, 64 (2014), 285-291.
- 10) H. Yoshida and Y. Ookubo: Mater. Trans., 56 (2015), 1960–1967.
- 11) 浅野峰生,中村拓郎,吉田英雄:軽金属, 64 (2014), 279-284.
- 12) 山本 悟:新しい反応速度論の試み,昭和堂,(1979).
- 13) 山本 悟, 久保田耕平:日本金属学会誌, 46 (1982), 917-924.
- 14) 久保田耕平,山本 悟:日本金属学会誌, 9 (1982), 908-916.
 15) W. A. Johnson and R. F. Mehl: Trans. ALME, 135 (1939), 416-458.
- 16) M. Avrami: J. Chem. Phys., 7(1939), 1103–1112, 8(1940), 212–224, 9(1941), 177–184.